

# **ЛЕКЦИЯ 2-9**

## **СИНХРОННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (SDRAM)**

## **SDR (Single Data Rate) SDRAM**

SDRAM (Synchronous DRAM) – синхронная динамическая память с произвольным доступом. Память работала синхронно с контроллером памяти, что гарантировало завершение цикла чтения/записи строк в заданное время. В SDRAM памяти было увеличено количество матриц памяти с одной до двух, иногда до четырех. Это позволило во время обращения к одной матрице памяти регенерировать строки другой матрицы, что, в свою очередь, позволило поднять тактовую частоту работы памяти, из-за уменьшения задержек на регенерацию.

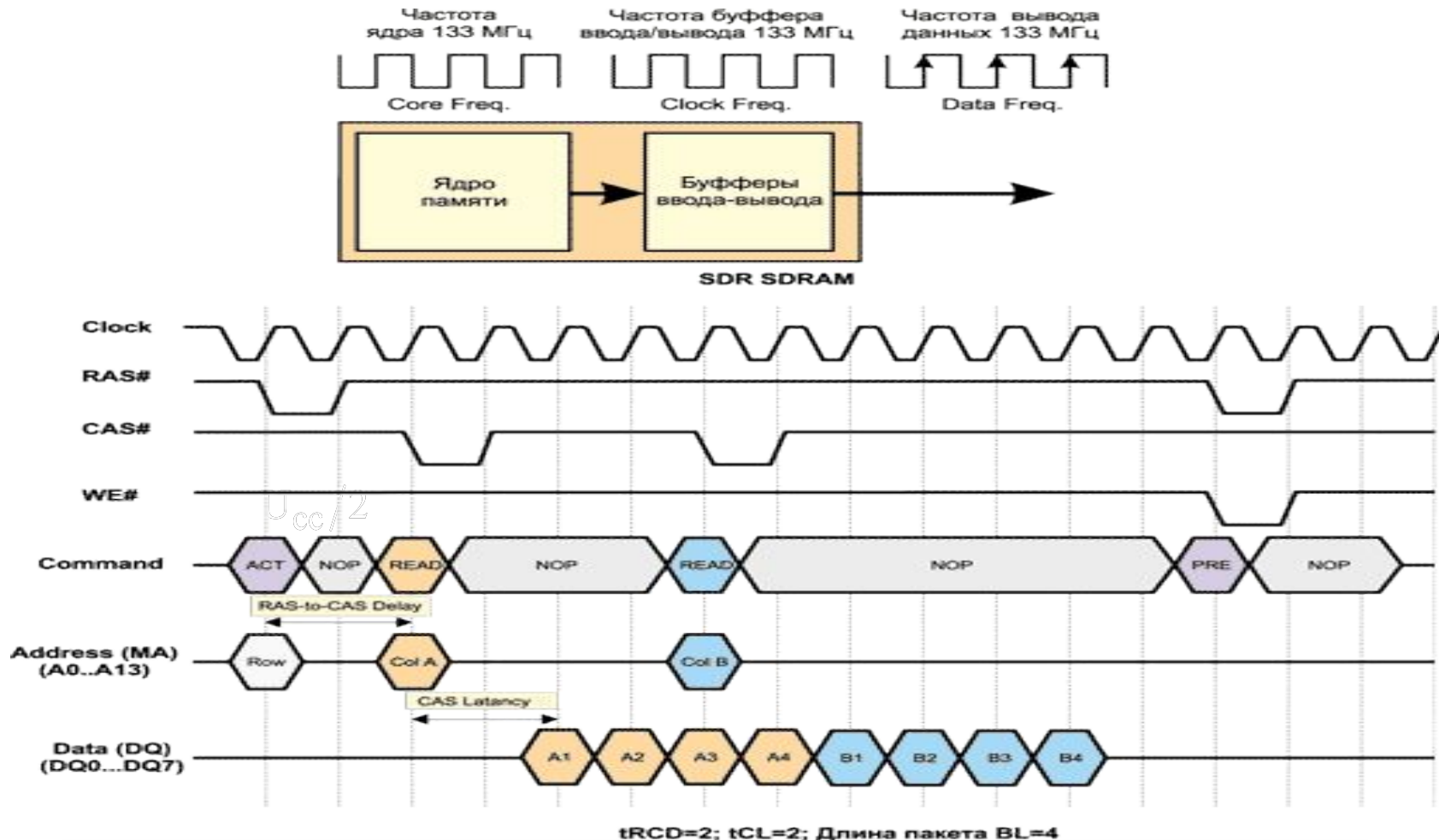
В SDR SDRAM-памяти обеспечивается синхронизация всех входных и выходных сигналов с положительными фронтами импульсов тактового генератора.

Весь массив памяти SDRAM-модуля разделен на два независимых банка. В SDR-памяти организована пакетная обработка данных, что позволяет производить обращение по новому адресу столбца ячейки памяти на каждом тактовом цикле. Длина пакета (Burst Length, BL) может составлять 2, 4 или 8 байт.

В SDR-памяти ядро памяти и буферы обмена работают в синхронном режиме на одной и той же частоте. Передача каждого бита из буфера происходит с каждым тактом работы ядра памяти.

# SDR (Single Data Rate) SDRAM

Упрощенная временная диаграмма работы памяти SDR в режиме чтения при длине пакета BL = 4 и таймингах  $t_{RCD} = 2$  и  $t_{CL} = 2$  показана на рисунке.



## **DDR (Double Data Rate) SDRAM**

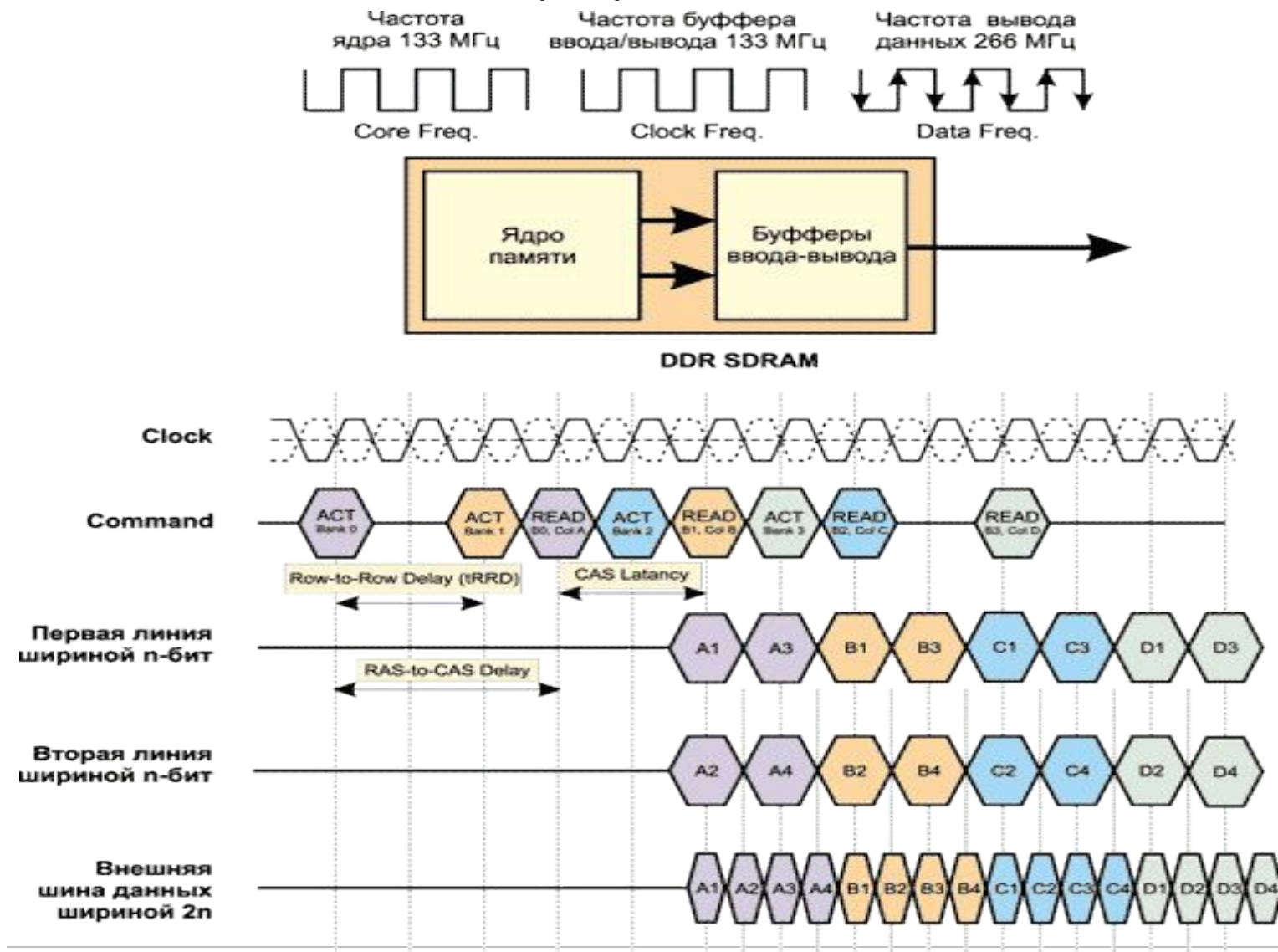
DDR SDRAM – синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной частотой передачи данных. Обмен данными по внешней шине идет не только по фронту тактового импульса, но и по спаду. В результате, без увеличения тактовой частоты внешней шины удваивается объем передаваемой информации.

Так как увеличить частоту работы оперативной памяти довольно сложно, увеличили разрядность внутренней шины данных (от ячеек матриц памяти до буферов ввода-вывода) и сделали ее в два раза большей, чем разрядность внешней шины памяти (от контроллера памяти до микросхемы памяти). Т.е. за 1 такт считывалось столько данных, сколько могло передаваться по внешней шине только за два такта ( $2n$  Prefetch - предвыборка  $2n$  бит). Для памяти DDR минимальная длина пакета составляет 2.

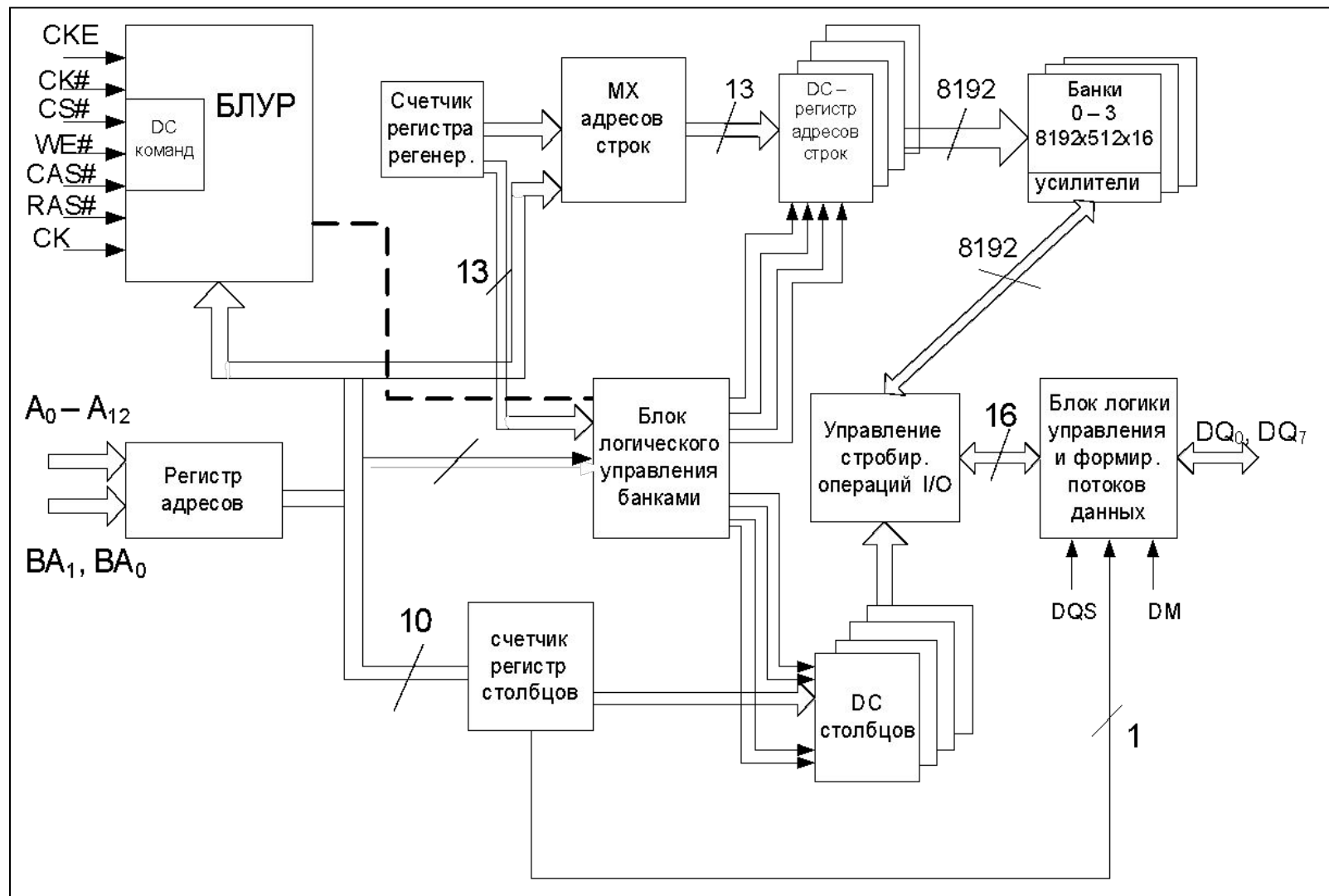
Отличительной особенностью DDR-памяти является реализация четырех логических банков. Напряжение питания – 2,5V.

Из-за необходимости применять мультиплексор, для объединения двух частей данных, передаваемых в оперативную память, и демultipлексор, для разделения считываемых данных из памяти на две части, сильно выросла латентность памяти. Латентность – это время между запросом данных из памяти и временем, когда оперативная память начнет выдавать требуемые данные.

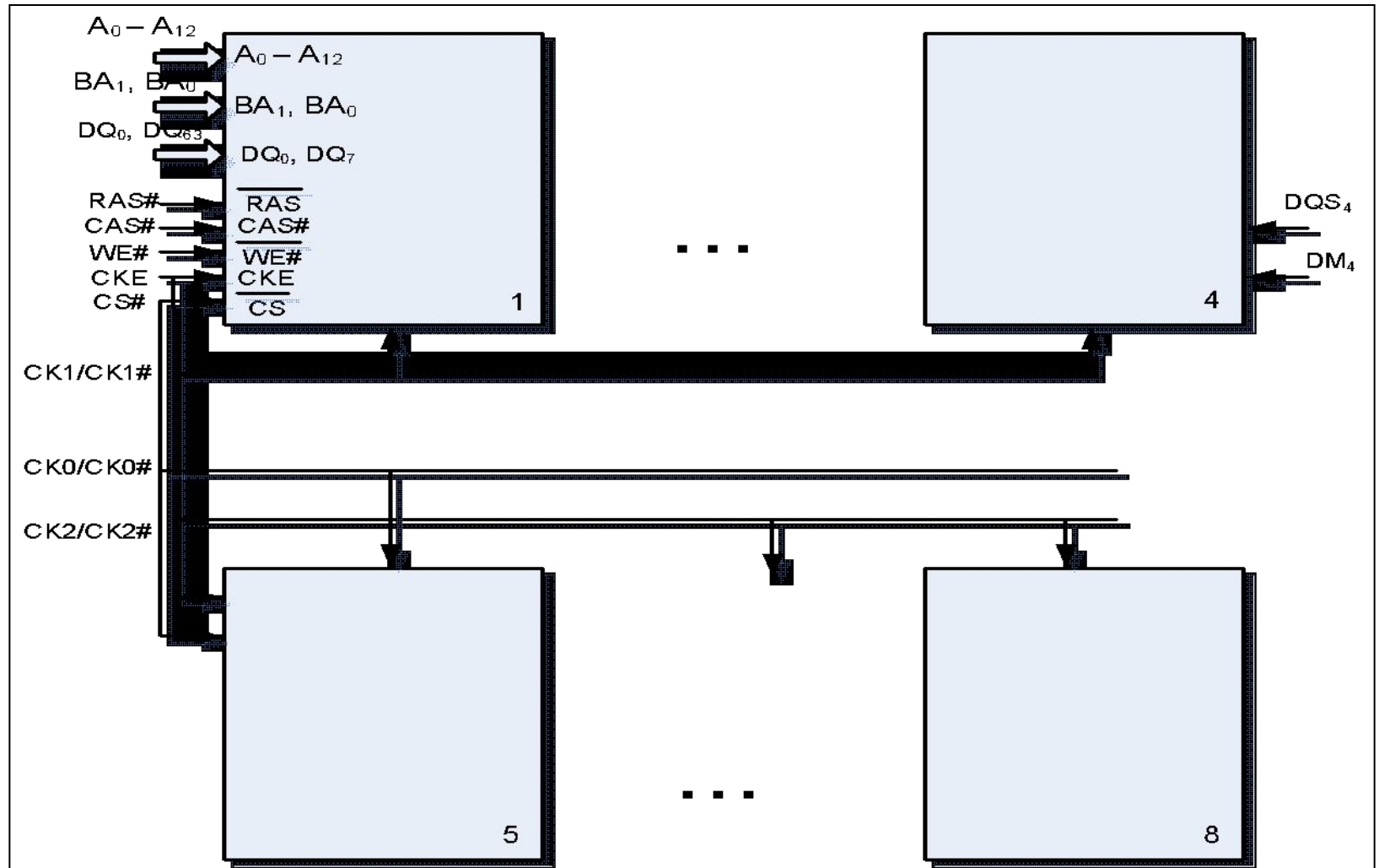
Упрощенная временная диаграмма работы DDR-памяти на примере операции чтения показана на рисунке.



Структурная организация ИМС DDR объемом 32 Мб  
(8192 строк, в каждой 512 блоков по 16 байт -  $2^3 \times 2^9 \times 2 \times 4 = 2^{15} = 32 \text{ Мб}$ )



На основе таких ИМС DDR организовывается модуль памяти на 256 МВ



## DDR2 SDRAM

В памяти DDR2 SDRAM ширина внутренней шины данных была увеличена еще в два раза и стала превосходить внешнюю шину данных в четыре раза. В результате, при одной и той же тактовой частоте внешней шины памяти у памяти DDR2 SDRAM внутренняя тактовая частота была в два раза меньше, по сравнению с памятью DDR SDRAM (4n Prefetch - предвыборка 4n бит).

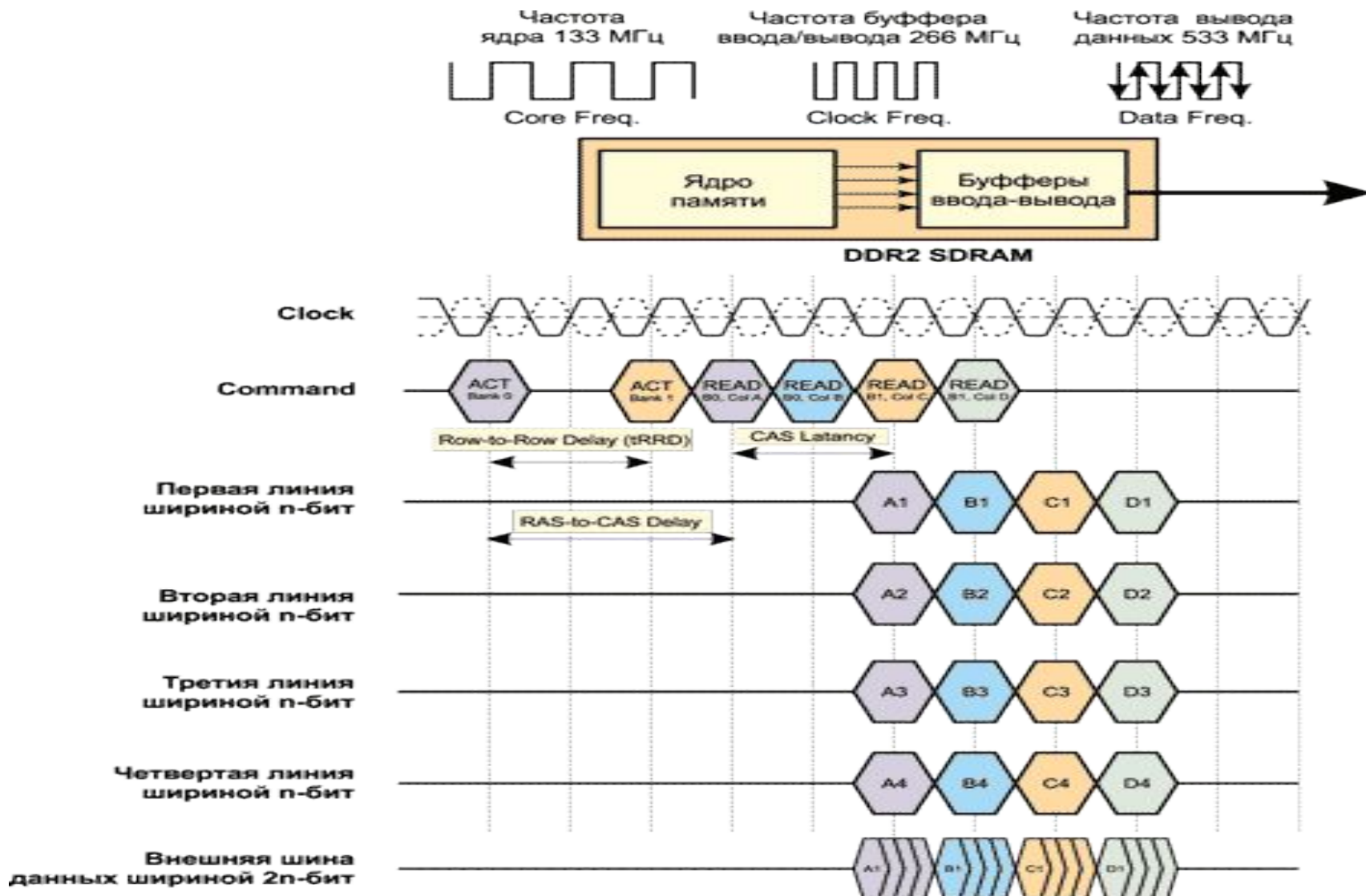
Снижение внутренней частоты функционирования микросхем, наряду со снижением номинального питающего напряжения с 2.5 до 1.8 V позволило ощутимо снизить потребляемую мощность.

С другой стороны, архитектура 4n-prefetch микросхем DDR2 позволяет достичь вдвое большую частоту внешней шины данных по сравнению с частотой внешней шины данных микросхем DDR — при равной внутренней частоте функционирования самих микросхем. на каждый «внутренний» такт микросхемы памяти приходится считывание/запись сразу четырех элементов данных (отсюда и название — 4n-prefetch), т.е. все операции внутри микросхемы памяти осуществляются на уровне «4-элементных» блоков данных.

Для памяти DDR2 минимальная длина пакета составляет 4.



Упрощенная временная диаграмма работы DDR2-памяти на примере операции чтения показана на рисунке.



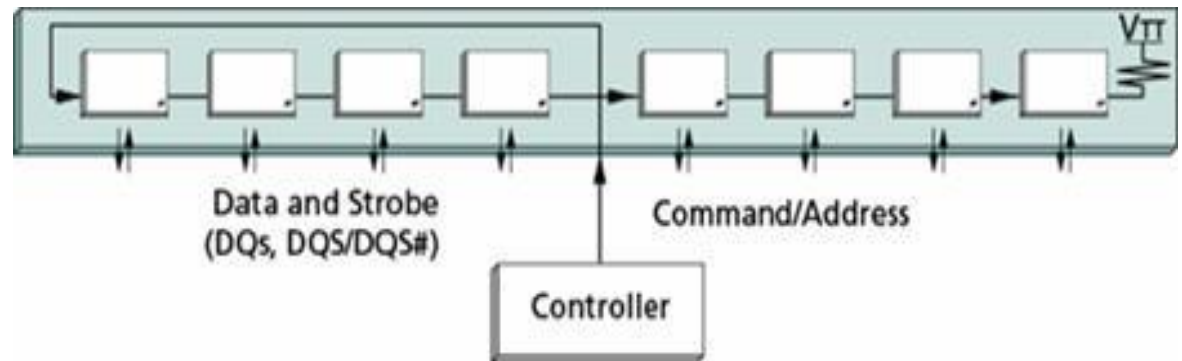
## DDR3 SDRAM

Теоретическая пропускная способность микросхем DDR3 вдвое выше по сравнению с DDR2 благодаря использованию схемы 8n-prefetch (против 4n-prefetch в DDR2). Количество логических банков в микросхемах DDR3 также увеличено вдвое и составляет 8 банков, что позволяет увеличить «параллелизм» при обращении к данным по схеме чередования логических банков и скрыть задержки, связанные с обращением к одной и той же строке памяти ( $t_{RP}$ ).

DDR3 характеризуются уровнем питающего напряжения 1.5 В.

Отличительной особенностью модулей памяти DDR3 является применение «сквозной», или «пролетной» (fly-by) архитектуры передачи адресов и команд, а также сигналов управления и тактовой частоты отдельным микросхемам модуля памяти с применением внешнего терминирования сигналов (резистором, расположенным на модуле памяти).

Она позволяет добиться увеличения качества передачи сигналов при высоких частотах,

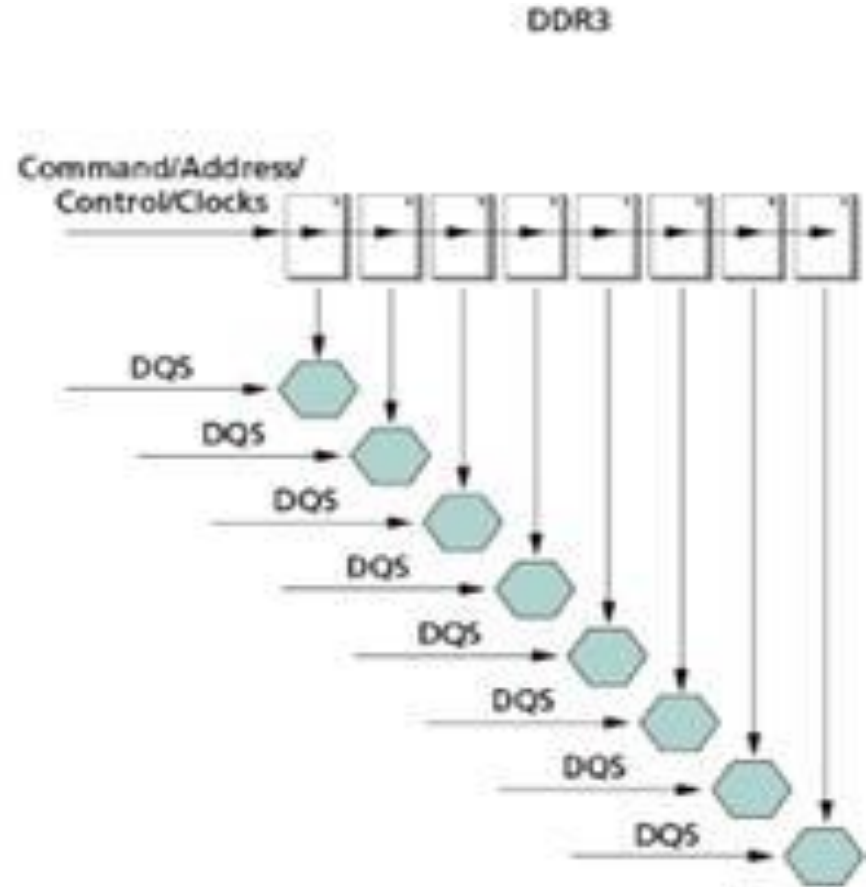
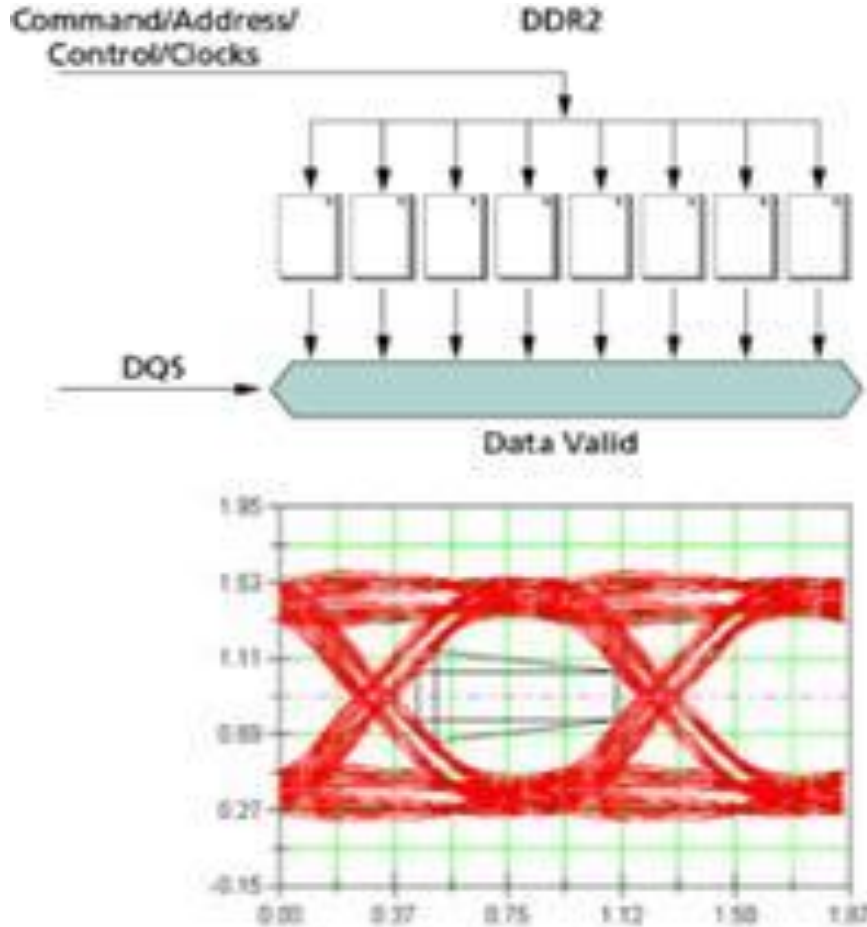


## DDR3 SDRAM

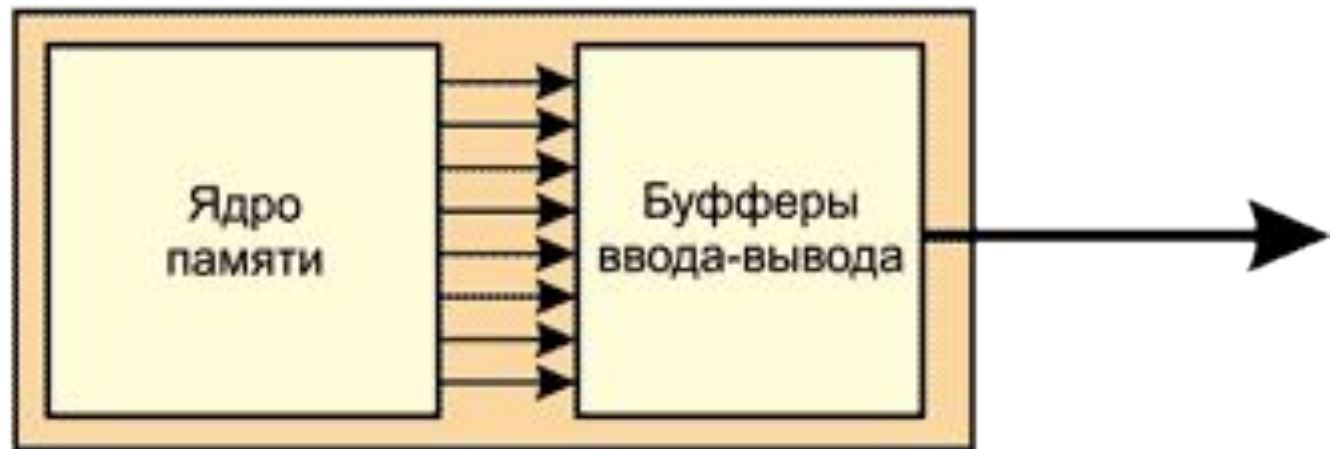
В модулях памяти DDR2 подача адресов и команд осуществляется параллельно на все микросхемы модуля, в связи с чем, например, при считывании данных, все восемь 8-битных элементов данных окажутся доступными в один и тот же момент времени и контроллер памяти сможет одновременно прочитать все 64 бита данных.

В модулях памяти DDR3 вследствие применения «пролетной» архитектуры подачи адресов и команд каждая из микросхем модуля получает команды и адреса с определенным отставанием относительно предыдущей микросхемы, поэтому элементы данных, соответствующие определенной микросхеме, также окажутся доступными с некоторым отставанием. Для минимизации задержек, в модулях памяти DDR3, по сравнению DDR2, реализован несколько иной подход ко взаимодействию контроллера памяти с шиной данных модуля памяти. Он называется «регулировкой уровня чтения/записи» (read/write leveling) и позволяет контроллеру памяти использовать определенное смещение по времени при приеме/передачи данных, соответствующее «запаздыванию» поступления адресов и команд (а, следовательно, и данных) в определенную микросхему модуля. Этим достигается одновременность считывания (записи) данных из микросхем (в микросхемы) модуля памяти.

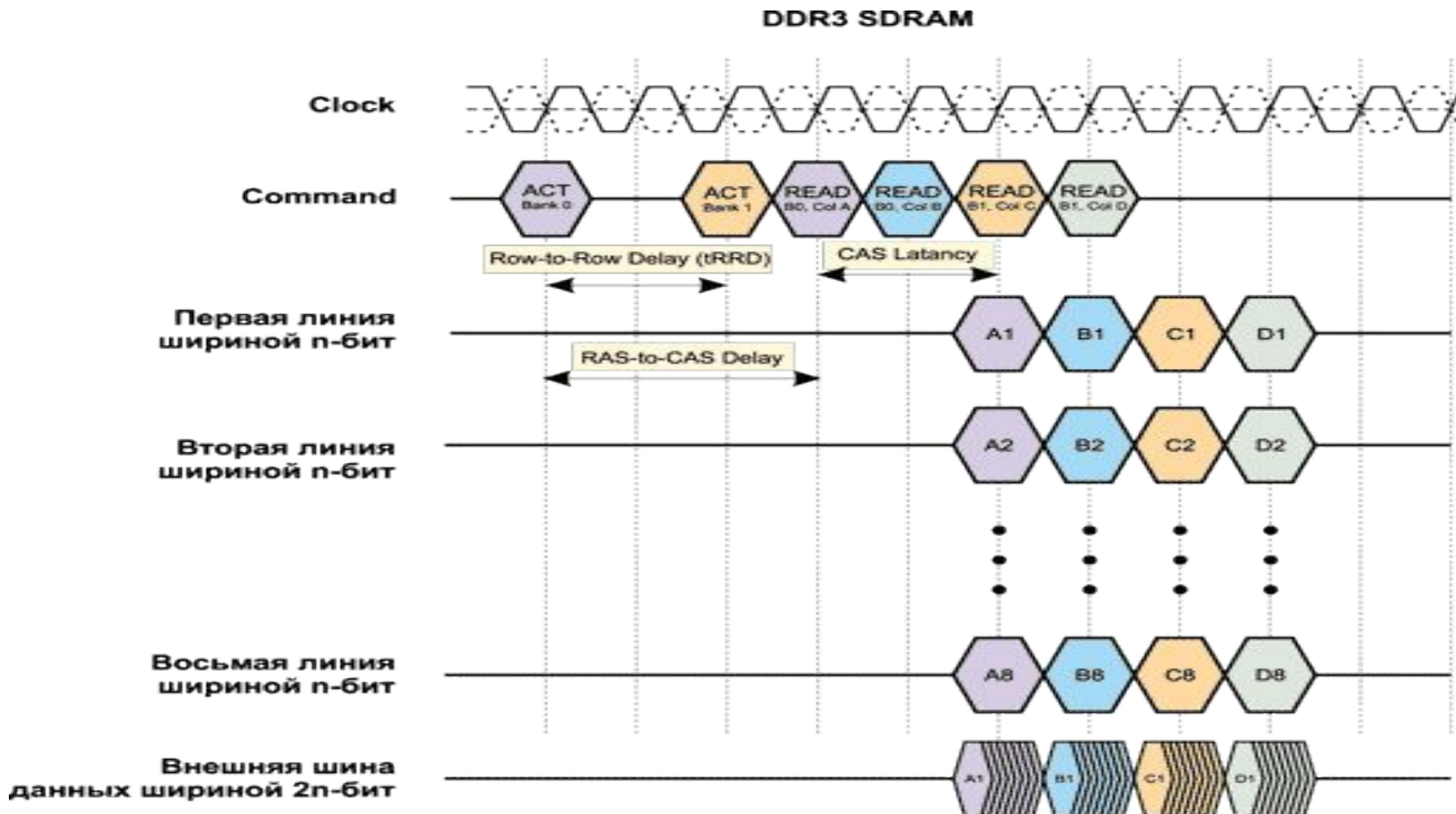
# Регулировка уровня чтения/записи (read/write leveling) в модулях памяти DDR3



# Реализация метода 8n-Prefetch



# Упрощенная временная диаграмма работы памяти DDR3





## DDR4 SDRAM

DDR4 переняла архитектуру  $2^n$ -prefetch. Любой чип памяти может состоять из двух или четырех отдельных групп банков.

Рассмотрим 8-гигабайтный DDR4-чип с шиной данных шириной 4 бита. Он содержит 4 группы банков по 4 банка в каждой. Внутри каждого банка находятся 131 072 ( $2^{17}$ ) строки емкостью 512 байт каждая. Для сравнения можно привести характеристики аналогичного DDR3-решения. Такой чип содержит 8 независимых банков. В каждом из банков находятся 65 536 ( $2^{16}$ ) строк, а в каждой строке — 2048 байт.

Как видно, длина каждой строки чипа DDR4 в четыре раза меньше длины строки DDR3. Это означает, что DDR4 осуществляет «просмотр» банков быстрее, нежели DDR3. При этом переключение между самими банками также происходит гораздо быстрее.

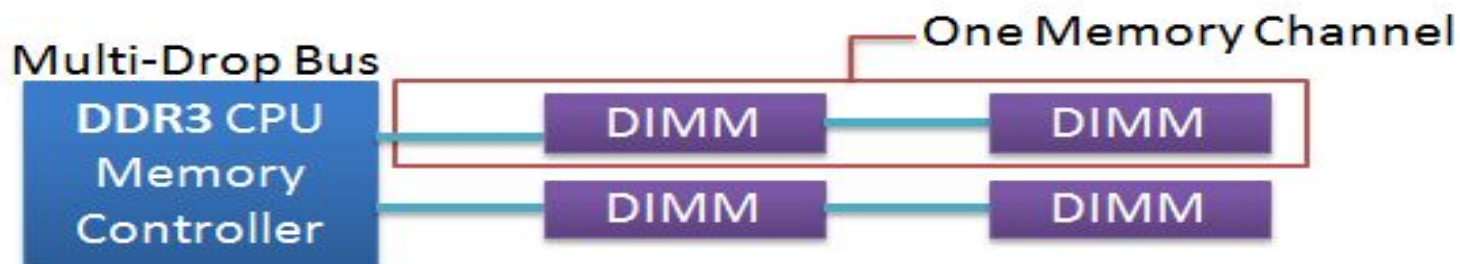
Отметим, что для каждой группы банков предусмотрен независимый выбор операций (активация, чтение, запись или регенерация), что позволяет повысить эффективность и пропускную способность памяти.



# DDR4 SDRAM

Важным изменением в стандарте DDR4 стало использование интерфейса с топологией «точка-точка» вместо шины Multi-Drop, применяемой в DDR3. Снижение рабочего напряжения до 1,2 В.

## [Схема работы шины Multi-Drop](#)



## [Схема работы шины с топологией «точка-точка»](#)



## **DDR5 SDRAM**

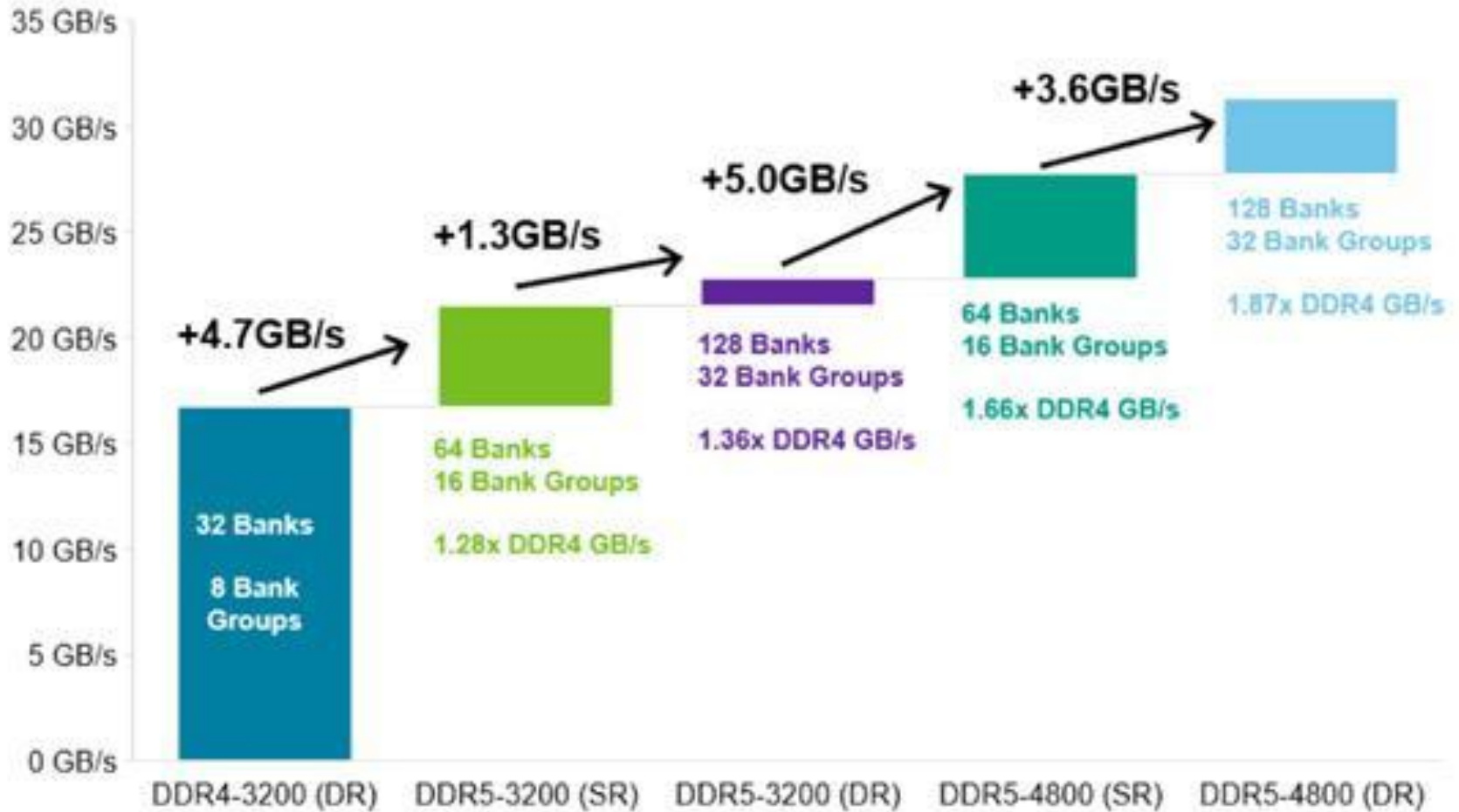
DDR5 — синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных пятого поколения — новый перспективный стандарт оперативной памяти. Новая спецификация обещает гораздо более высокую производительность, чем у последнего внедрённого стандарта DDR4, а также пониженное энергопотребление (1,1 В).

Оперативная память DDR5 будет отличаться удвоенной ёмкостью и удвоенной производительностью по сравнению с модулями DDR4 первого поколения.

Скорость передачи данных у DDR4 варьируется от 1600 до 3200 мегатранзакций в секунду (MT/sec). DDR5 увеличивает её до 3200-6400 MT/sec.

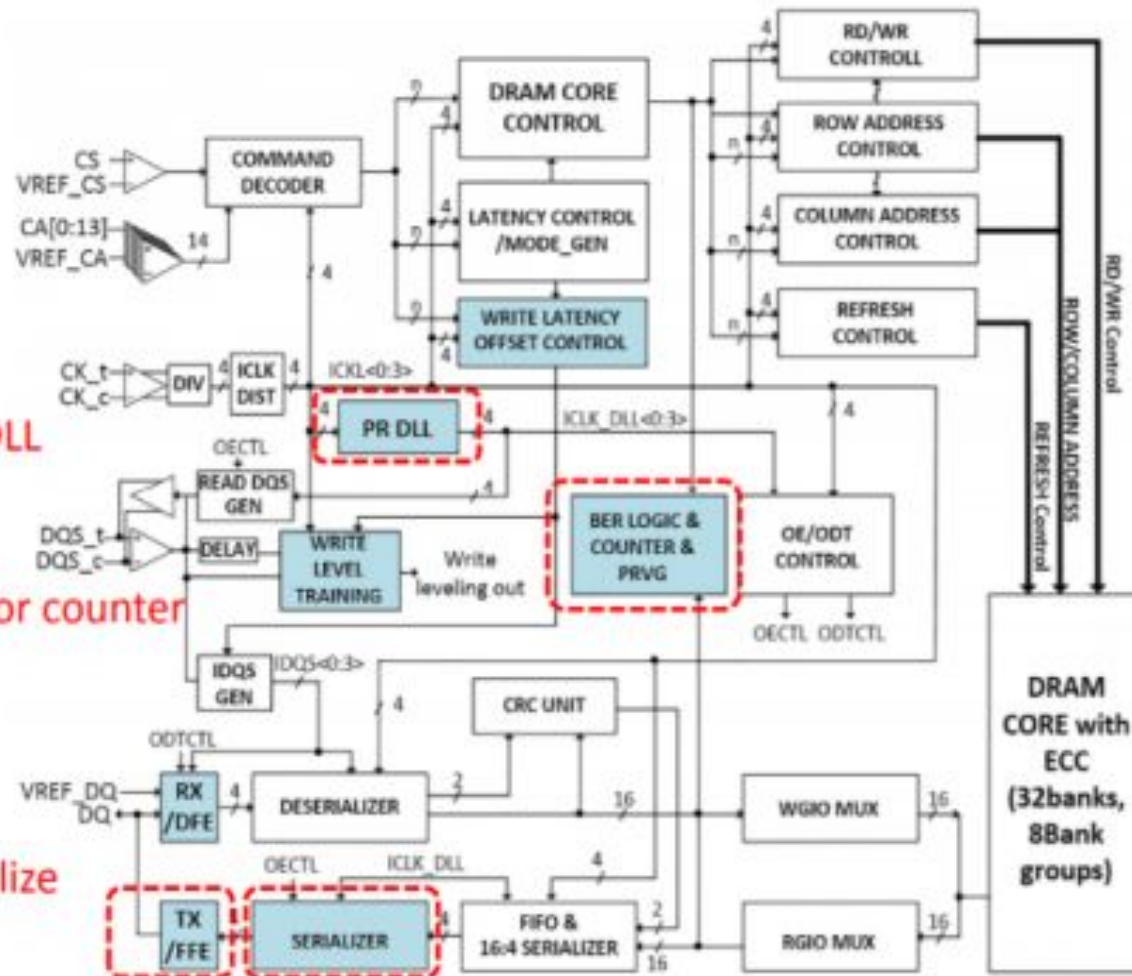
На 3200 MT/sec, DDR4 имеет эффективную пропускную способность 134,3 ГБ/с, DDR5 3200 обеспечит 182,5 ГБ/с, что больше в 1,36х, а у DDR5 4800 прирост скорости составит >1,85х.

# SDRAM



# DDR5 Block diagram

- Phase rotator DLL
- BER Logic & Error counter
- FFE for Tx equalize
- 4:1 serializer



# SDRAM

| Тип  | Год выпуска | Пропускная способность | Контактов на чипе | Напряжени<br>е (В) | Предвыборк<br>а |
|------|-------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| SDR  | 1993        | 1,6 ГБ/с               | 168               | 3,3                | 1n              |
| DDR  | 2000        | 3,2 ГБ/с               | 184               | 2,5/2,6            | 2n              |
| DDR2 | 2003        | 8,5 ГБ/с               | 240               | 1,8                | 4n              |
| DDR3 | 2007        | 17 ГБ/с                | 240               | 1,35/1,5           | 8n              |
| DDR4 | 2014        | 25,6 ГБ/с              | 380               | 1,2                | 8n              |
| DDR5 | 2019        | 32 ГБ/с                | 380               | 1,1                | 8/16n           |

# **Достоинства и недостатки динамической памяти**

## *Преимущества динамической памяти:*

- низкая себестоимость;
- высокая степень упаковки, позволяющая создавать чипы памяти большого объема.

## *Недостатки динамической памяти:*

- относительно невысокое быстродействие, так как процесс зарядки и разрядки конденсатора занимает гораздо больше времени, чем переключение триггера;
- высокая латентность, в основном, из-за внутренней шины данных, в несколько раз более широкой, чем внешняя, и необходимости использования мультиплексора/демультиплексора;
- необходимость регенерации заряда конденсатора, из-за его быстрого саморазряда, ввиду микроскопических размеров.